










	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6410DQ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7.8A 8-TSSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SI6410DQ-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 30431 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI6410DQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7.8A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30431 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 7.8A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6410DQ-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 1.5W (Ta) Surface Mount 8-TSSOP
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI6410DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6410DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6410DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI6410DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6404DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8.6A 8TSSOP</p>	 <p>SI6413DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 7.2A 8TSSOP</p>	 <p>SI6411DQ-T1-E3 VISHAY SI6411DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI6413DQ V SI6413DQ V</p>
 <p>SI6410DQ SI SI6410DQ SI</p>	 <p>SI6410DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.8A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6405DQ-T1-E3 VISHAY SI6405DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI6413DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 7.2A 8TSSOP</p>

SI6410DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6410DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6410DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6410DQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6410DQ-T1-GE3
SI6410DQ-T1-GE3 Electronic	SI6410DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6410DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6410DQ-T1-GE3-Bild	SI6410DQ-T1-GE3 Teil	SI6410DQ-T1-GE3-Inventar
SI6410DQ-T1-GE3 Preis	SI6410DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6410DQ-T1-GE3 Bild	SI6410DQ-T1-GE3 Aktie	SI6410DQ-T1-GE3 Online bestellen	
SI6410DQ-T1-GE3 Neu	SI6410DQ-T1-GE3 Original	SI6410DQ-T1-GE3 garantiert	SI6410DQ-T1-GE3 RFQ		

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited